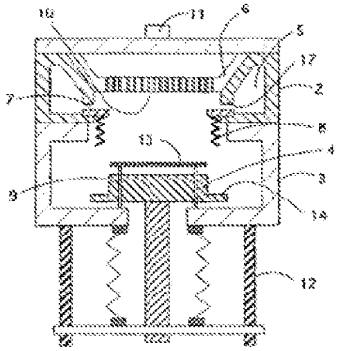


图 1

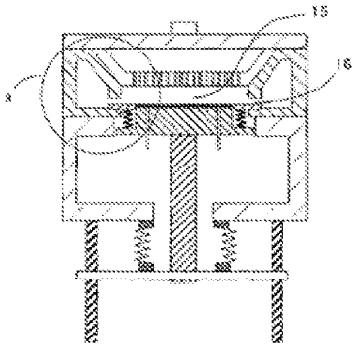


图 2

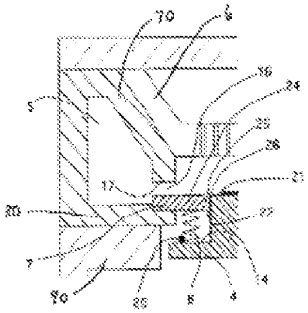


图 3

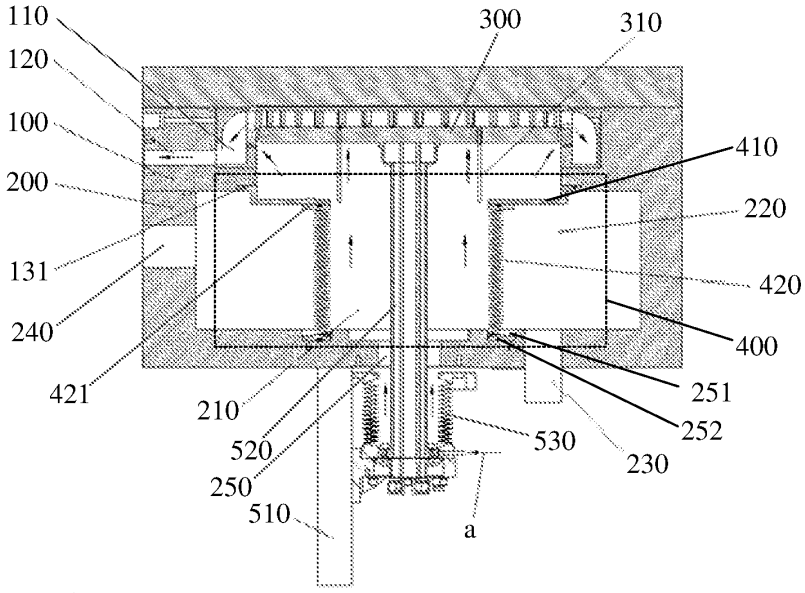

110
120
100
200
131
240
421
300
310
410
220
420
400
251
252
230
530
210
520
250
510
a

图 4

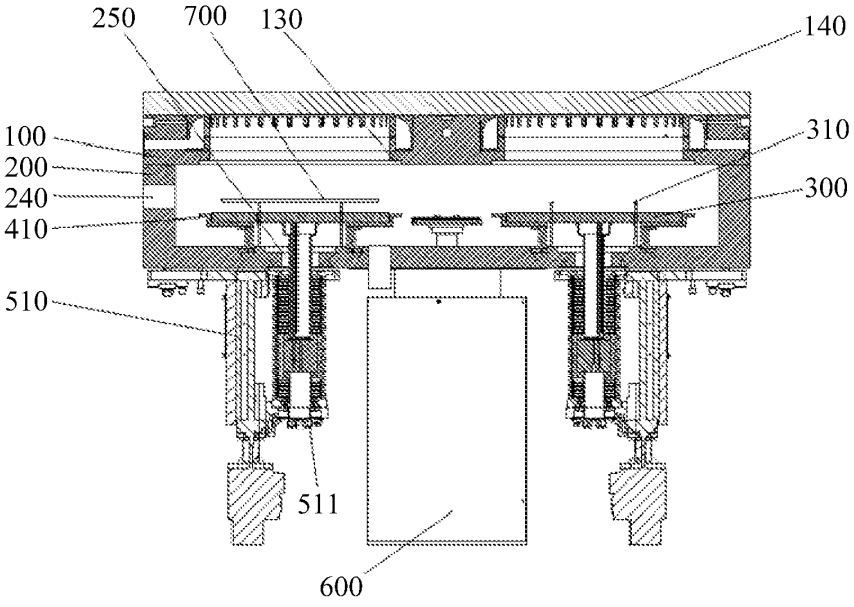

250
700
130
140
100
200
240
410
510
310
300
511
600

图 5

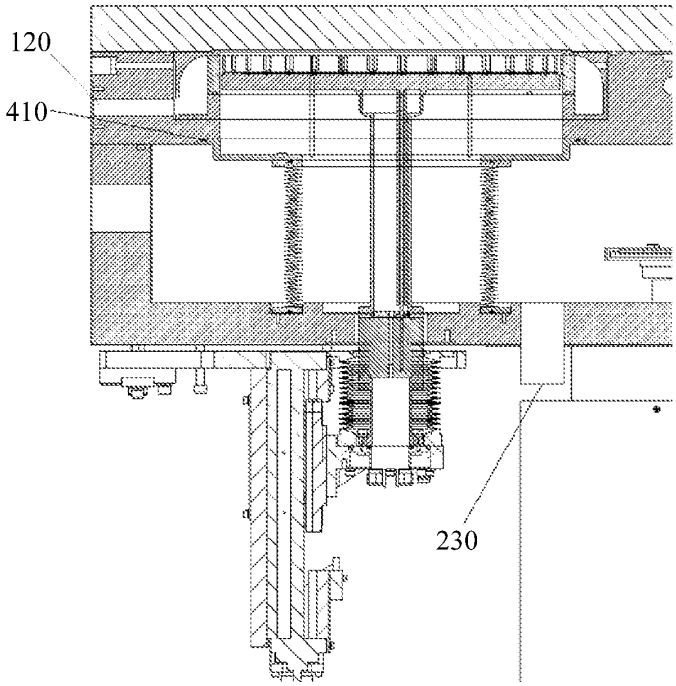


图 6

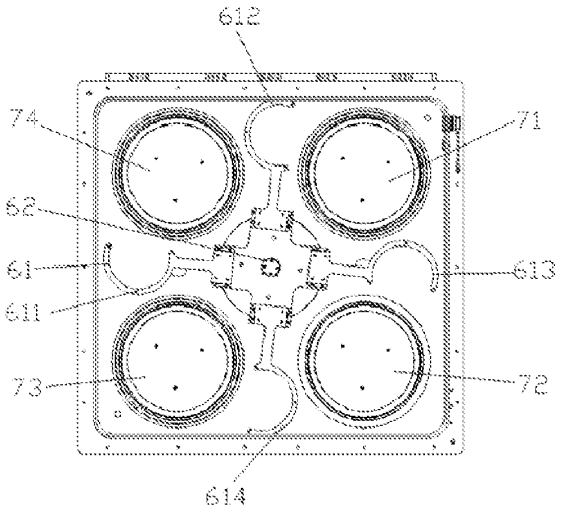


图 7

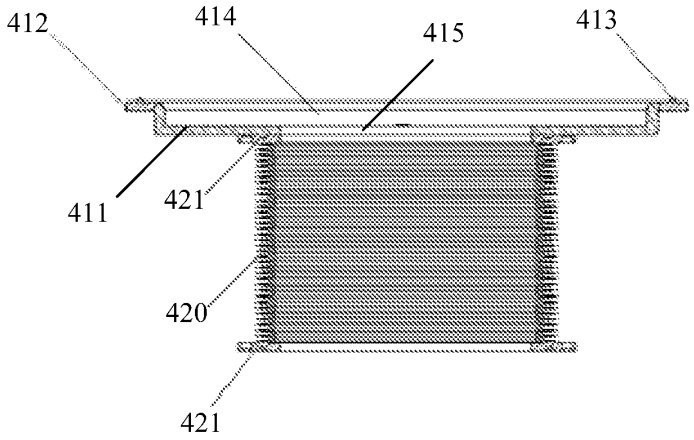

412
414
415
413
411
421
420
421

图 8

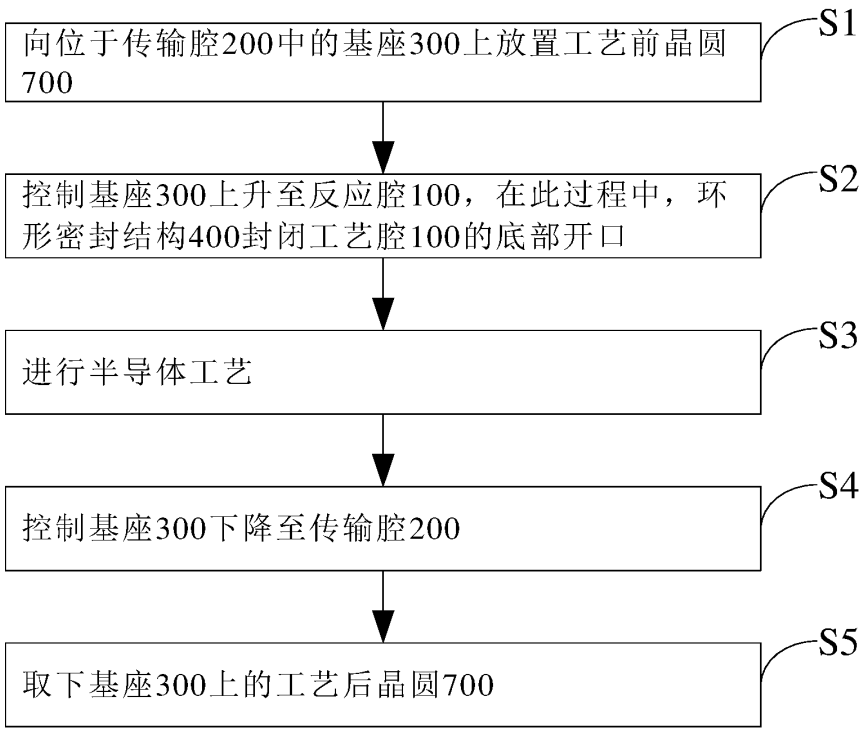

向位于传输腔200中的基座300上放置工艺前晶圆700
S1
控制基座300上升至反应腔100，在此过程中，环形密封结构400封闭工艺腔100的底部开口
S2
进行半导体工艺
S3
控制基座300下降至传输腔200
S4
取下基座300上的工艺后晶圆700
S5

图 9

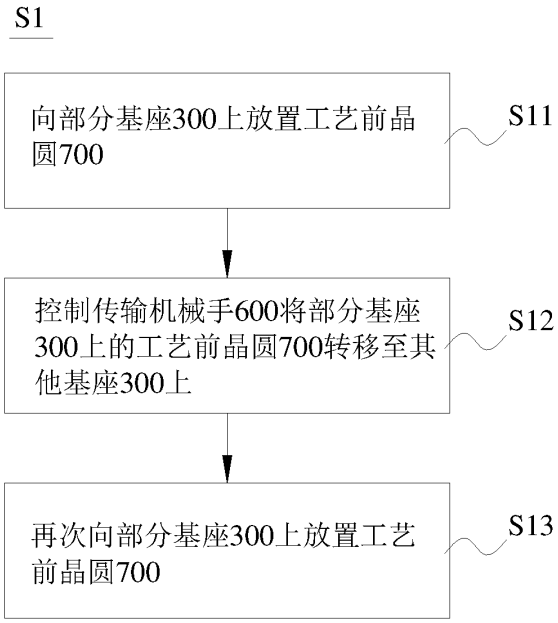

S1
向部分基座300上放置工艺前晶圆700
S11
控制传输机械手600将部分基座300上的工艺前晶圆700转移至其他基座300上
S12
再次向部分基座300上放置工艺前晶圆700
S13

图 10

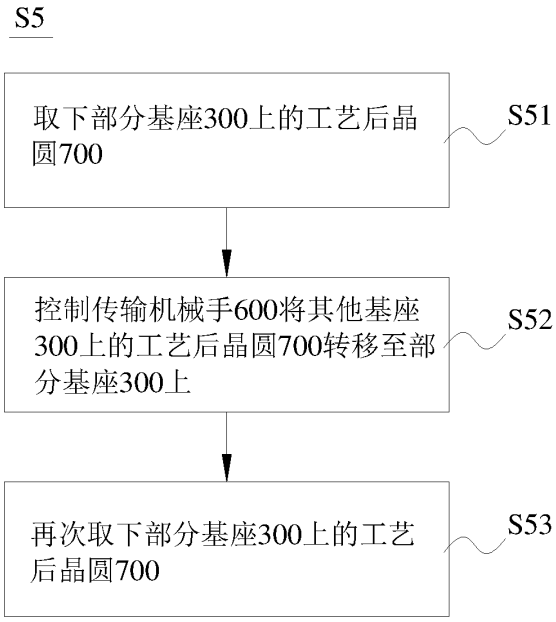

S5
取下部分基座300上的工艺后晶圆700
S51
控制传输机械手600将其他基座300上的工艺后晶圆700转移至部分基座300上
S52
再次取下部分基座300上的工艺后晶圆700
S53

图 11